

DERWENT-ACC-NO: 2002-168964

DERWENT-WEEK: 200222

COPYRIGHT 2005 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Mask pattern design method for lithography
 process in semiconductor device manufacture, involves
 synthesizing plus and minus correction layer with OPC
 correction layer to produce mask pattern

PATENT-ASSIGNEE: TOSHIBA KK [TOKE]

PRIORITY-DATA: 2000JP-0187867 (June 22, 2000)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE
PAGES MAIN-IPC		
<u>JP 2002006475 A</u>	January 9, 2002	N/A
007 G03F 001/08		

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DESCRIPTOR	APPL-NO
APPL-DATE		
JP2002006475A	N/A	2000JP-0187867
June 22, 2000		

INT-CL (IPC): G03F001/08, H01L021/027

ABSTRACTED-PUB-NO: JP2002006475A

BASIC-ABSTRACT:

NOVELTY - Original design pattern is changed until the difference in target pattern and simulation pattern is below regulation value. Plus and minus correction layer is produced and OPC correction is performed to modified final original design pattern to form OPC correction pattern. Plus and minus correction layers are synthesized with OPC correction pattern to produce mask pattern.

DETAILED DESCRIPTION - An INDEPENDENT CLAIM is also included for mask.

USE - For lithography process in a semiconductor device manufacture.

ADVANTAGE - Strict pattern correction is performed and good quality mask pattern is obtained.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows the flowchart explaining mask pattern design method. (Drawing includes non-English language text).

CHOSEN-DRAWING: Dwg. 2/7

TITLE-TERMS: MASK PATTERN DESIGN METHOD LITHO PROCESS SEMICONDUCTOR DEVICE

MANUFACTURE PLUS MINUS CORRECT LAYER CORRECT LAYER
PRODUCE MASK
PATTERN

DERWENT-CLASS: P84 U11

EPI-CODES: U11-C04D; U11-C04E1;

SECONDARY-ACC-NO:

Non-CPI Secondary Accession Numbers: N2002-129462

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-6475

(P2002-6475A)

(43)公開日 平成14年1月9日(2002.1.9)

(51)Int.Cl'

G 0 3 F 1/08
H 0 1 L 21/027

識別記号

F I

G 0 3 F 1/08
H 0 1 L 21/30

マーク(参考)

A 2 H 0 9 5
5 0 2 P

審査請求 未請求 請求項の数 6 OL (全 7 頁)

(21)出願番号 特願2000-187867(P2000-187867)

(22)出願日 平成12年6月22日(2000.6.22)

(71)出願人 000003078

株式会社東芝

東京都港区芝浦一丁目1番1号

(72)発明者 野嶋 茂樹

神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株式会社東芝横浜事業所内

(72)発明者 白井 駿

神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株式会社東芝横浜事業所内

(74)代理人 100058479

弁理士 鈴江 武彦 (外6名)

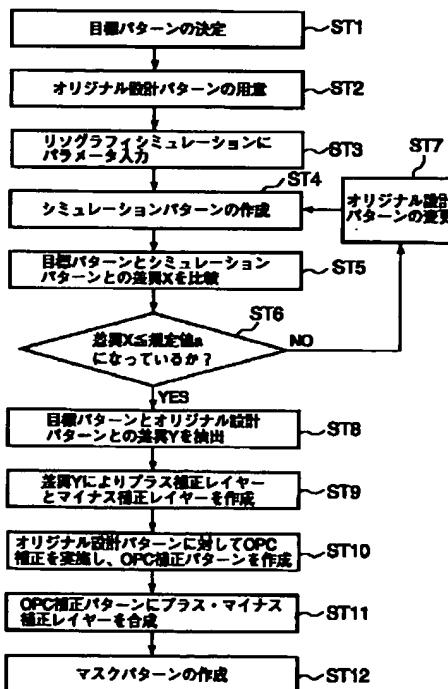
Fターム(参考) 2H095 B401 BB01 BB36

(54)【発明の名称】 マスクパターン設計方法及びその方法により形成されるマスク

(57)【要約】

【課題】 厳密なパターン補正が可能なマスクパターン設計方法及びその方法により形成されるマスクを提供する。

【解決手段】 目標パターンとシミュレーションパターンとの差異が規定値以下になるまでオリジナル設計パターンが変更される。この変更後のオリジナル設計パターンと目標パターンとの差異を抽出し、プラス・マイナス補正レイヤーが作成される。次に、変更後のオリジナル設計パターンに対してOPC補正が行われ、OPC補正パターンが形成される。このOPC補正パターンにプラス・マイナス補正レイヤーを合成することによりマスクパターンが形成される。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 目標パターンを形成するための第1のオリジナル設計パターンを用意する工程と、前記第1のオリジナル設計パターンに対してシミュレーションによる計算を行い、シミュレーションパターンを作成する工程と、前記目標パターンと前記シミュレーションパターンとを比較し、差異Xが規定値以下となるまで前記第1のオリジナル設計パターンの変更を行い、前記差異Xが規定値以下となる第2のオリジナル設計パターンを作成する工程と、

前記第2のオリジナル設計パターンと前記目標パターンとの差異Yを抽出する工程と、

前記差異Yを考慮して、前記第2のオリジナル設計パターンに対してプラス補正レイヤー及びマイナス補正レイヤーを作成する工程と、

OPCツールを用いて、前記第2のオリジナル設計パターンに対してOPC補正を行い、OPC補正パターンを作成する工程と、

前記OPC補正パターンに前記プラス補正レイヤー及び前記マイナス補正レイヤーを合成することにより、マスクパターンを作成する工程とを含むことを特徴とするマスクパターン設計方法。

【請求項2】 目標パターンを形成するための第1のオリジナル設計パターンを用意する工程と、

前記第1のオリジナル設計パターンに対してOPC補正を行い、第1のOPC補正パターンを作成する工程と、前記、第1のOPC補正パターンに対してシミュレーションによる計算を行い、シミュレーションパターンを作成する工程と、

前記目標パターンと前記シミュレーションパターンとを比較し、差異Xが規定値以下となるまで前記第1のオリジナル設計パターンの変更を行い、前記差異Xが規定値以下となる第2のオリジナル設計パターンを作成する工程と、

前記第2のオリジナル設計パターンと前記目標パターンとの差異Yを抽出する工程と、

前記差異Yを考慮して、前記第2のオリジナル設計パターンに対してプラス補正レイヤー及びマイナス補正レイヤーを作成する工程と、

前記第2のオリジナル設計パターンに対してOPC補正を行い、第2のOPC補正パターンを作成する工程と、前記第2のOPC補正パターンに前記プラス補正レイヤー及び前記マイナス補正レイヤーを合成することにより、マスクパターンを作成する工程とを含むことを特徴とするマスクパターン設計方法。

【請求項3】 前記シミュレーションパターンを作成する工程において、前記シミュレーションに、実際のマスク作成時に使用することが想定される照明条件及びプロセス条件のパラメータを入力することを特徴とする請求

2

項1又は2記載のマスクパターンの設計方法。

【請求項4】 目標パターンを形成するための第1のオリジナル設計パターンを用意する工程と、

前記第1のオリジナル設計パターンに対してシミュレーションによる計算を行い、シミュレーションパターンを作成する工程と、

前記目標パターンと前記シミュレーションパターンとを比較し、差異Xが規定値以下となるまで前記第1のオリジナル設計パターンの変更を行い、前記差異Xが規定値以下となる第2のオリジナル設計パターンを作成する工程と、

10 以下となる第2のオリジナル設計パターンを作成する工程と、

前記第2のオリジナル設計パターンと前記目標パターンとの差異Yを抽出する工程と、

前記差異Yを考慮して、前記第2のオリジナル設計パターンに対してプラス補正レイヤー及びマイナス補正レイヤーを作成する工程と、

OPCツールを用いて、前記第2のオリジナル設計パターンに対してOPC補正を行い、OPC補正パターンを作成する工程と、

20 前記OPC補正パターンに前記プラス補正レイヤー及び前記マイナス補正レイヤーを合成することにより、マスクパターンを作成する工程とにより形成されることを特徴とするマスク。

【請求項5】 目標パターンを形成するための第1のオリジナル設計パターンを用意する工程と、

前記第1のオリジナル設計パターンに対してOPC補正を行い、第1のOPC補正パターンを作成する工程と、前記、第1のOPC補正パターンに対してシミュレーションによる計算を行い、シミュレーションパターンを作成する工程と、

30 成する工程と、

前記目標パターンと前記シミュレーションパターンとを比較し、差異Xが規定値以下となるまで前記第1のオリジナル設計パターンの変更を行い、前記差異Xが規定値以下となる第2のオリジナル設計パターンを作成する工程と、

前記第2のオリジナル設計パターンと前記目標パターンとの差異Yを抽出する工程と、

前記差異Yを考慮して、前記第2のオリジナル設計パターンに対してプラス補正レイヤー及びマイナス補正レイヤーを作成する工程と、

40 前記第2のオリジナル設計パターンに対してOPC補正を行い、第2のOPC補正パターンを作成する工程と、

前記第2のOPC補正パターンに前記プラス補正レイヤー及び前記マイナス補正レイヤーを合成することにより、マスクパターンを作成する工程とにより形成されることを特徴とするマスク。

【請求項6】 前記シミュレーションパターンを作成する工程において、前記シミュレーションに、実際のマスク作成時に使用することが想定される照明条件及びプロセス条件のパラメータを入力することを特徴とする請求

項4又は5記載のマスク。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体装置におけるリソグラフィ工程で用いられるマスクパターン設計方法及びその方法により形成されるマスクに関する。

【0002】

【従来の技術】近年、半導体デバイスの微細化に伴い、露光で解像する寸法が小さくなると、実際のマスクパターン通りに像を転写することができなくなり、仕上がりのデザインが設計デザインと異なるという問題が生じていた。

【0003】この問題は、例えば、パターンニングする配線の周囲の環境が異なる場合、すなわち、隣り合う配線までの距離が異なる場合、この距離の異なりにより、ウエハ上に仕上がった配線幅が設計と異なってくるという問題があった。

【0004】これを回避するために、従来は、例えば線幅と隣り合う配線間の距離とに応じて補正量を定め、設計パターン上の補正を行うパターンと隣接するパターンまでの距離に応じて補正量を変化させる補正技術（OPC=Optical Proximity Correction）を用いて、設計パターンを補正し、マスクパターンを作成してきた。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記方法を用いた場合、例えば、配線が交差する領域、配線が短く1次元的な補正では完全に補正ができないような設計パターンの領域などでは、十分な補正精度が得られないなかつた。

【0006】そこで、十分な補正精度が得るために、設計段階でリソグラフィシミュレーションなどを用いて、設計パターンに補正图形を追加する方法も考えられる。しかし、設計後に行われるOPCにおいて、設計段階で補正されたパターンも再度補正の対象となるため、過補正になるという問題があった。

【0007】本発明は上記課題を解決するためになされたものであり、その目的とするところは、厳密なパターン補正が可能なマスクパターン設計方法及びその方法により形成されるマスクを提供することにある。

【0008】

【課題を解決するための手段】本発明は、前記目的を達成するために以下に示す手段を用いている。

【0009】本発明の第1のマスクパターン設計方法は、目標パターンを形成するための第1のオリジナル設計パターンを用意する工程と、前記第1のオリジナル設計パターンに対してシミュレーションによる計算を行い、シミュレーションパターンを作成する工程と、前記目標パターンと前記シミュレーションパターンとを比較し、差異Xが規定値以下となるまで前記第1のオリジナル設計パターンの変更を行い、前記差異Xが規定値以下

となる第2のオリジナル設計パターンを作成する工程と、前記第2のオリジナル設計パターンと前記目標パターンとの差異Yを抽出する工程と、前記差異Yを考慮して、前記第2のオリジナル設計パターンに対してプラス補正レイヤー及びマイナス補正レイヤーを作成する工程と、OPCツールを用いて、前記第2のオリジナル設計パターンに対してOPC補正を行い、OPC補正パターンを作成する工程と、前記OPC補正パターンに前記プラス補正レイヤー及び前記マイナス補正レイヤーを合成することにより、マスクパターンを作成する工程とを含んでいる。

【0010】本発明の第2のマスクパターン設計方法

は、目標パターンを形成するための第1のオリジナル設計パターンを用意する工程と、前記第1のオリジナル設計パターンに対してOPC補正を行い、第1のOPC補正パターンを作成する工程と、前記、第1のOPC補正パターンに対してシミュレーションによる計算を行い、シミュレーションパターンを作成する工程と、前記目標パターンと前記シミュレーションパターンとを比較し、

差異Xが規定値以下となるまで前記第1のオリジナル設計パターンの変更を行い、前記差異Xが規定値以下となる第2のオリジナル設計パターンを作成する工程と、前記第2のオリジナル設計パターンと前記目標パターンとの差異Yを抽出する工程と、前記差異Yを考慮して、前記第2のオリジナル設計パターンに対してプラス補正レイヤー及びマイナス補正レイヤーを作成する工程と、前記第2のOPC補正パターンを作成する工程と、前記第2のOPC補正パターンに前記プラス補正レイヤー及び前記マイナス補正レイヤーを合成することにより、マスクパターンを作成することを含んでいる。

【0011】上記本発明の第1、第2のマスクパターン設計方法による前記シミュレーションパターンを作成する工程において、前記シミュレーションに、実際のマスク作成時に使用することが想定される照明条件及びプロセス条件のパラメータを入力することが望ましい。

【0012】本発明の第1のマスクは、目標パターンを形成するための第1のオリジナル設計パターンを用意する工程と、前記第1のオリジナル設計パターンに対して

シミュレーションによる計算を行い、シミュレーションパターンを作成する工程と、前記目標パターンと前記シミュレーションパターンとを比較し、差異Xが規定値以下となるまで前記第1のオリジナル設計パターンの変更を行い、前記差異Xが規定値以下となる第2のオリジナル設計パターンを作成する工程と、前記第2のオリジナル設計パターンと前記目標パターンとの差異Yを抽出する工程と、前記差異Yを考慮して、前記第2のオリジナル設計パターンに対してプラス補正レイヤー及びマイナス補正レイヤーを作成する工程と、OPCツールを用いて、前記第2のオリジナル設計パターンに対してOPC

補正を行い、OPC補正パターンを作成する工程と、前記OPC補正パターンに前記プラス補正レイヤー及び前記マイナス補正レイヤーを合成することにより、マスクパターンを作成する工程により形成されている。

【0013】本発明の第2のマスク、目標パターンを形成するための第1のオリジナル設計パターンを用意する工程と、前記第1のオリジナル設計パターンに対してOPC補正を行い、第1のOPC補正パターンを作成する工程と、前記、第1のOPC補正パターンに対してシミュレーションによる計算を行い、シミュレーションパターンを作成する工程と、前記目標パターンと前記シミュレーションパターンとを比較し、差異Xが規定値以下となるまで前記第1のオリジナル設計パターンの変更を行い、前記差異Xが規定値以下となる第2のオリジナル設計パターンを作成する工程と、前記第2のオリジナル設計パターンと前記目標パターンとの差異Yを抽出する工程と、前記差異Yを考慮して、前記第2のオリジナル設計パターンに対してプラス補正レイヤー及びマイナス補正レイヤーを作成する工程と、前記第2のオリジナル設計パターンに対してOPC補正を行い、第2のOPC補正パターンを作成する工程と、前記第2のOPC補正パターンに前記プラス補正レイヤー及び前記マイナス補正レイヤーを合成することにより、マスクパターンを作成する工程により形成されている。

【0014】上記本発明の第1、第2のマスクによる前記シミュレーションパターンを作成する工程において、前記シミュレーションに、実際のマスク作成時に使用することが想定される照明条件及びプロセス条件のパラメータを入力することが望ましい。

【0015】

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態を以下に図面を参照して説明する。

【0016】本発明の第1、第2の実施例では、市販のリソグラフィシミュレータと市販のOPC (Optical Proximity Correction) ツールを用いて所望のパターンを形成する方法を説明する。尚、本発明を説明するために本発明のフローを経る前の設計パターンを「オリジナル設計パターン」といい、ウエハ上で所望する形状のパターンを「目標パターン」という。

【0017】[第1の実施例] 第1の実施例は、目標パターンに対する実際のパターンの差異からプラス・マイナス補正量を検討し、このプラス・マイナス補正をOPC補正が行われた後に行うことにある。

【0018】図1は、本発明の第1の実施例によるマスクパターンの設計方法を示す。ここで、ST1乃至ST9はマスクを補正するための検討工程を示し、ST10乃至ST12はマスクの補正工程を示している。以下、図1に示すフローチャートに沿って、第1の実施例に係るマスクパターンの設計方法について説明する。

【0019】まず、図2に示すように、ウエハ上で所望

する形状のパターンを検討し、目標パターン11を決定する(ST1)。次に、目標パターン11が形成できると予想されるオリジナル設計パターンを用意する(ST2)。

【0020】次に、市販のリソグラフィシミュレーションに、実際のマスク作成時に使用することが想定される照明条件(例えば、NA、σ、e(輪帶遮蔽率)、defocusなど)と、必要な場合はプロセス条件(例えば、レジストの光学定数、レジスト特性、エッチング特性など)などのパラメータが入力される(ST3)。

【0021】次に、前記パラメータを用いて、オリジナル設計パターンに対してリソグラフィシミュレーションによる計算が行われる。その結果、図2に示すように、ウエハ上で得られるパターン(以下、シミュレーションパターンと称す)12が作成される(ST4)。

【0022】次に、目標パターン11とシミュレーションパターン12とを比較し(ST5)、差異Xが規定値a(例えばa=10nm)以下であるか否かを判断する(ST6)。

【0023】ここで、差異Xが規定値a以上である場合、オリジナル設計パターンの変更が行われ(ST7)、新たなオリジナル設計パターンが形成される。ここで、変更後のオリジナル設計パターンとしては、例えば、ショートニングを考慮して変更前のオリジナル設計パターンよりも大面積を有するパターンの形状が用意される。

【0024】その後、再度、前記パラメータを用いて、変更後のオリジナル設計パターンに対してリソグラフィシミュレーションによる計算が行われる。その結果、シミュレーションパターンが得られ(ST4)、このシミュレーションパターンと目標パターンとの差異Xが比較される(ST5)。

【0025】このように、ST4乃至ST7の処理が繰り返され、シミュレーションパターンと目標パターンとの差異Xが規定値a以下となるまでオリジナル設計パターンの変更が行われる。

【0026】次に、シミュレーションパターンと目標パターンとの差異Xが規定値a以下となった後、この際用いられた変更後のオリジナル設計パターンと目標パターンとの差異Yが抽出される(ST8)。

【0027】ここで、図2に示すように、領域Aにおいては、目標パターン11よりもシミュレーションパターン12が細くなっている。また、領域Bにおいては、目標パターン11よりもシミュレーションパターン12が太くなっている。

【0028】したがって、図3に示すように、例えば領域Aに対しては、オリジナル設計パターン13に加えるレイヤー(プラス補正レイヤー)14が作成され、例えば領域Bに対しては、オリジナル設計パターンから削るレイヤー(マイナス補正レイヤー)15が作成される

(ST9)。

【0029】次に、市販のOPCツールなどを用いて、変更後のオリジナル設計パターンに対してOPC補正を実施し、図4に示すように、OPC補正パターン16を作成する(ST10)。

【0030】次に、図5に示すように、OPC補正パターン16にプラス補正レイヤー14を加え、OPC補正パターン16からマイナス補正レイヤー15を削除する(ST11)。その結果、図6に示すように、ウエハ上で所望するパターンを得ることのできるマスクパターン17が作成される(ST12)。

【0031】上記第1の実施例によれば、補正の必要な領域を検討した後、この領域のみにプラス・マイナス補正が行われるため、厳密なマスクパターンの形成が可能となる。

【0032】また、OPC補正とプラス・マイナス補正とを組み合わせた処理を行うことにより、従来技術よりもさらに厳密なマスクパターンの形成が可能となる。したがって、従来よりも厳密な補正パターンができるまでの最終的な処理時間を短縮することができる。

【0033】さらに、リソグラフィシミュレーションに、実際のマスク作成時に使用することが想定される照明条件やプロセス条件などのパラメータを入力し、シミュレーションパターンを形成することにより、実際のマスクパターンの形成に必要な補正パターンを厳密に検討することができる。

【0034】[第2の実施例] 第2の実施例は、第1の実施例と同様に、目標パターンに対する実際のパターンの差異からプラス・マイナス補正量を検討し、このプラス・マイナス補正をOPC補正が行われた後に行い、さらに、プラス・マイナス補正量の検討においてOPC補正による結果を用いていることに特徴がある。

【0035】第2の実施例において、上記第1の実施例と同様の工程については説明を簡略化し、異なる工程のみ詳細に説明する。

【0036】図7は、本発明の第2の実施例によるマスクパターンの設計方法を示す。ここで、ST1乃至ST9はマスクを補正するための検討処理を示し、ST10乃至ST12はマスクの補正処理を示している。以下、図7に示すフローチャートに沿って、第2の実施例に係るマスクパターンの設計方法について説明する。

【0037】まず、第1の実施例と同様に、図2に示すように、ウエハ上で所望する形状のパターンを検討し、目標パターン11を決定する(ST1)。次に、目標パターン11が形成できると予想されるオリジナル設計パターンを用意する(ST2)。その後、オリジナル設計パターンに対してOPCを実施し、OPC補正パターンが作成される(ST2')。

【0038】次に、市販のリソグラフィシミュレーションに、実際にマスク作成時に使用することが想定される

照明条件(例えば、NA、 σ 、 ϵ (輪帯遮蔽率)、defocusなど)と、必要な場合は、プロセス条件(例えば、レジストの光学定数、レジスト特性、エッチング特性など)などのパラメータが入力される(ST3)。

【0039】次に、前記パラメータを用いて、OPC補正パターンに対してリソグラフィシミュレーションによる計算が行われる。その結果、ウエハ上で得られるパターン(以下、シミュレーションパターンと称す)12が得られる(ST4)。

10 11 【0040】次に、目標パターン11とシミュレーションパターン12とを比較し(ST5)、差異Xが規定値a(例えばa=10nm)以下であるか否かを判断する(ST6)。

【0041】ここで、差異Xが規定値a以上である場合、オリジナル設計パターンの変更が行われ(ST7)、新たなオリジナル設計パターンが形成される。

【0042】その後、再度、前記パラメータを用いて、変更後のオリジナル設計パターンに対してリソグラフィシミュレーションによる計算が行われる。その結果、シ

20 ミュレーションパターンが得られ(ST4)、このシミュレーションパターンと目標パターンとの差異Xが比較される(ST5)。

【0043】このように、シミュレーションパターンと目標パターンとの差異Xが規定値a以下となるまでオリジナル設計パターンの変更が行われ、ST4乃至ST7の処理が繰り返される。

30 31 【0044】次に、シミュレーションパターンと目標パターンとの差異Xが規定値a以下となった後、この際用いられた変更後のオリジナル設計パターンと目標パターンとの差異Yが抽出される(ST8)。

【0045】次に、オリジナル設計パターンに加えるレイヤー(プラス補正レイヤー)13、オリジナル設計パターンから削るレイヤー(マイナス補正レイヤー)14が作成される(ST9)。

【0046】次に、市販のOPCツールなどを用いて、変更後のオリジナル設計パターンに対してOPCを実施し、OPC補正パターン16を作成する(ST10)。

【0047】次に、OPC補正パターン16にプラス補正レイヤー14を加え、OPC補正パターン16からマイナス補正レイヤー15を削除する(ST11)。その結果、ウエハ上で所望するパターンを得ることのできるマスクパターン16が作成される(ST12)。

【0048】上記第2の実施例によれば、第1の実施例と同様の効果が得られる。さらに、プラス・マイナス補正量の検討においてOPC補正による結果を用いているため、第1の実施例よりもさらに厳密にマスク補正パターンを形成できる。

【0049】その他、本発明は、その要旨を逸脱しない範囲で、種々変形して実施することが可能である。

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、厳密なパターン補正が可能なマスクパターン設計方法及びその方法により形成されるマスクを提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例に係わるマスクパターン設計方法のフローチャート。

【図2】本発明の第1の実施例に係わるマスクパターン設計方法(ST1乃至ST8)を示す図。

【図3】本発明の第1の実施例に係わるマスクパターン設計方法(ST9)を示す図。

【図4】本発明の第1の実施例に係わるマスクパターン設計方法(ST10)を示す図。

【図5】本発明の第1の実施例に係わるマスクパターン

設計方法(ST11)を示す図。

【図6】本発明の第1の実施例に係わるマスクパターン設計方法(ST12)を示す図。

【図7】本発明の第2の実施例に係わるマスクパターン設計方法のフローチャート。

【符号の説明】

1 1…目標パターン、

1 2…シミュレーションパターン、

1 3…変更後のオリジナル設計パターン、

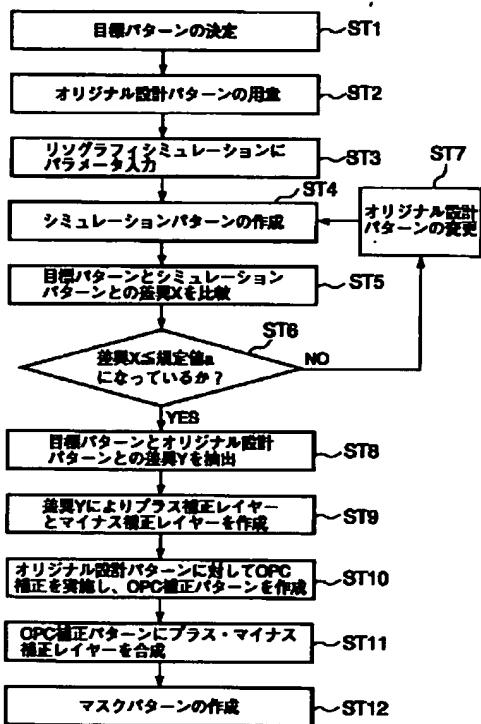
1 4…プラス補正レイヤー、

1 5…マイナス補正レイヤー、

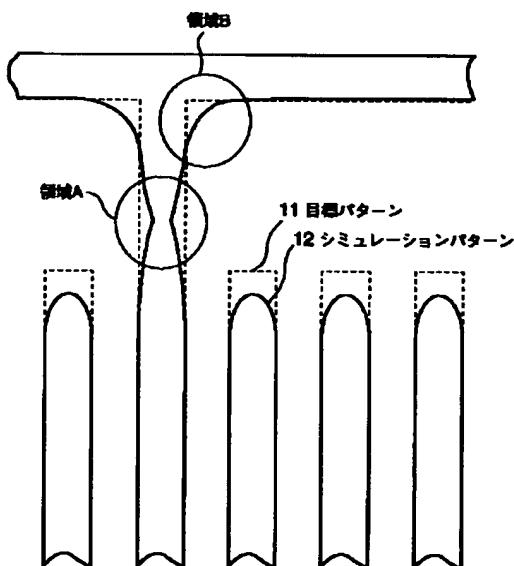
1 6…OPC補正パターン、

1 7…マスクパターン。

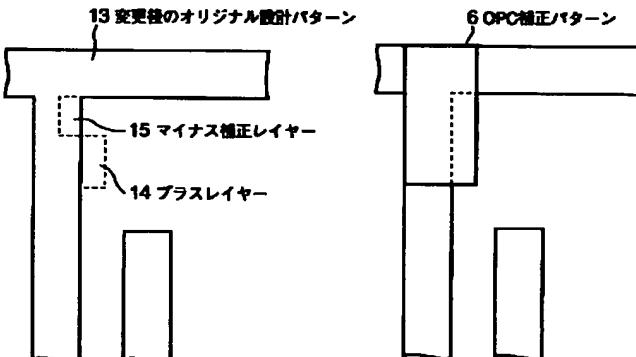
【図1】



【図2】

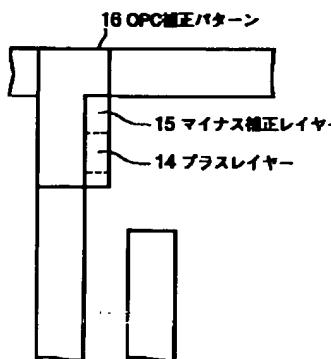


【図3】

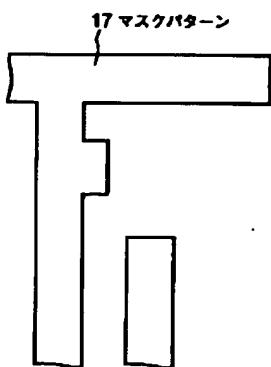


【図4】

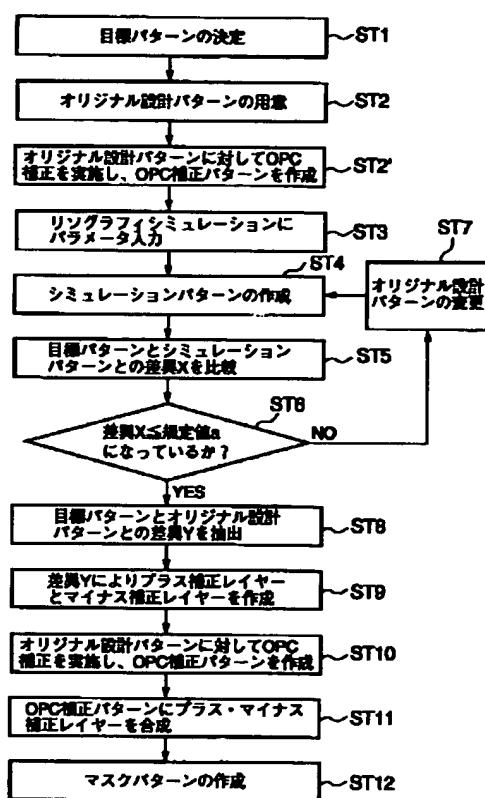
【図5】



【図6】



【図7】



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.